

5月25日(水)

- 強誘電体材料(I)** (座長) 坂部 行雄 (村田製作所) 10:30--12:00
- (25-F-1) Preparation and Curie Temperatures of Nanosized (Pb,Sr)TiO₃ Powders
(富山県大工) 張 帆, 唐木 智明, 安達 正利
- (25-F-2) 点欠陥の光学活性を用いたBaTiO₃の微小応力解析
(村田製作所, *京都工芸繊維大) 山下 裕久, 山本 宏, 坂部 行雄, ジュセツペ
ベツオツテイ
- (25-F-3) 積層セラミックスコンデンサーのDCバイアス電界下での容量劣化機構
(東工大院理工, *太陽誘電) 鶴見 敬章, 庄野 元浩, 掛本 博文, 和田 智志, 斉藤
賢二*, 茶園 広一*
- (25-F-4) インクジェット法によるジルコニア基板上への(Ba,Sr)TiO₃厚膜の作製
(富山工業技術センタ, *産総研, **富山県立大) 坂井 雄一, 二口 友昭, 飯島 高志*,
安達 正利**
- (25-F-5) Ba(Ti,Zr)O₃系Ni内部電極積層セラミックコンデンサの信頼性におよぼす粒界および偏析相の影響
(村田製作所) 岡松 俊宏, 佐野 晴信, 鷹木 洋
- (25-F-6) SrBi₂Ta₂O₉キャパシターの室温経時劣化と回復
(京大エネルギー科学) 玉井 慎一, 小林 啓之, 前田 佳均, 野沢 博
- 薄膜(I)** (座長) 清水 勝 (兵庫県立大学) 13:15--14:45
- (25-T-1) 28GHzマイクロ波照射により結晶化したPZT薄膜の電気的特性と微細組織
(東北大工, *産総研) 王 占杰, 粉川 博之, 滝沢 博胤, 一木 正聡*, 前田 龍太郎*
- (25-T-2) PZT薄膜におけるバッファ層による応力制御と誘電特性
(東工大院) 藤戸 啓輔, 脇谷 尚樹, 篠崎 和夫, 水谷 惟恭
- (25-T-3) (111)高配向チタン酸ジルコン酸鉛系強誘電体材料のインプリント現象の評価
(セイコーエプソン) 濱田 泰彰, 木島 健, 宮澤 弘, 下田 達也
- (25-T-4) 強誘電体記録を目的とした強誘電体薄膜の分極反転特性
(八戸工大, *芝浦工大, **ヤーマン) 越前 正洋, 増田 陽一郎, 山口 正樹*, 高島 啓**
- (25-T-5) 異なる厚みをもつPbZr_{0.3}Ti_{0.7}O₃薄膜の強誘電性及びメモリ特性に及ぼす等方加圧アニール処理の影響
(兵庫県立大) 福島 浩次, 小舟 正文, 西岡 雄亮, 山路 徹, 矢澤 哲夫
- (25-T-6) 希土類元素置換PZT薄膜の結晶構造と強誘電特性
(上智大, 高知工科大*, 物材研**, 東京工大***) 内田 寛, 中木 寛, 西田 謙*, 長田
実**, 舟窪 浩***, 幸田清一郎
- 圧電材料(I)** (座長) 鶴見 敬章 (東京工業大学) 15:00--16:15
- (25-P-1) PbZrO₃-PbTiO₃-Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃圧電セラミックスの相境界近傍組成における非線形
定数
(防衛大機能材料) 田代 新二郎, 徳永 亘, 石井 啓介, 永田 邦裕

- (25-P-2) PbTiO_3 - $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ 系電歪セラミックスのハイパワー特性
(リードテクノ, *早大, **長岡工専, ***龍谷大) 早野 修二, 高橋 貞行*, 梅田 幹雄**, 松田 諭***, 和田 隆博***
- (25-P-3) 高誘電率、高結合係数リラクサ系圧電材料の設計
(東芝研究開発センタ) 山下 洋八, 細野 靖晴
- (25-P-4) $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ - PbTiO_3 単結晶での巨大横効果圧電性
(静岡理工科大, *JFEミネラル) 小川 敏夫, 松下 三芳*, 岩崎 洋介*
- (25-P-5) モルフォトロピック相境界近傍の強誘電体固溶体単結晶 $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ - PbTiO_3 の圧電特性の静水圧力依存性
(岐阜大工, *川鉄鉱業, **東芝, ***名工大, ****愛知淑徳大) 安田 直彦, 伊藤 裕紀, 坂野 智一, 大和 英弘, 松下 三芳*, 山下 洋八**, 岩田 真***, 石橋 善弘****

薄膜(II)

(座長) 舟窪 浩 (東京工業大学)

16:30--18:00

- (25-T-7) 軟X線分光による $(\text{Pb},\text{La})(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$ 薄膜の電子構造
(東理大理, 東工大物創*) 樋口 透, 塚本 桓世, 服部 武志, 本田 佳久*, 横山 信太郎*, 舟窪 浩*
- (25-T-8) 化学溶液法により作製したPZT厚膜の圧電特性
(産総研) 飯島 高志, 大曾根 聡子, 下條 善朗, 大石 竜太郎, 永井 英幹
- (25-T-9) エアロゾルデポジション法で作製した強誘電体薄膜の広域誘電特性
(NEC基礎 環境, *産総研) 中田 正文, 大橋 啓之, 明渡 純*
- (25-T-10) $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ - PbTiO_3 薄膜の作製と特性
(湘南工大, 早大理工*) 真岩 宏司, 岡野 裕一, 一ノ瀬 昇*
- (25-T-11) エアロゾルデポジション法で成膜したリラクサ強誘電体厚膜(PNN-PZT)の熱処理による特性回復
(NEC トーキョー, *産総研) 川上 祥広, 明渡純*
- (25-T-12) MOCVD法により作製した PbTiO_3 ナノ構造の強誘電性
(*姫路工大, **兵庫県立大, ***富士通研究所) 岡庭 守*, 藤沢 浩訓**, 清水 勝**, 丹生 博彦**, 本田 耕一郎***

5月26日(木)

薄膜(III)

(座長) 加藤 一実 (産業技術総合研究所)

9:00--10:15

- (26-T-13) MOCVD法によりPt電極上に作製した(103),(116)配向SBT膜
(日本製鋼所) 加藤 恵子, 正田 満志, 金沢 正仁, 佐野 一也
- (26-T-14) $\text{SrBi}_2\text{Ta}_2\text{O}_9$ キャパシタのimprint特性におけるプロセスダメージ依存性
(沖電気SiSC研究本部) 足利 欣哉, 高屋 浩二, 金原 隆雄, 小岩 一郎
- (26-T-15) 電界印加焼成法による $(\text{Bi},\text{La})_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ 薄膜の作製と電気的諸特性
(*静岡県富士工技セ, **静大工) 中山 洋**, 杉山 治*, 真野 毅*, 渋谷 佳男*, 星 佑介**, 鈴木 久男**
- (26-T-16) 化学溶液法による $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ - $\text{SrBi}_4\text{Ti}_4\text{O}_{15}$ 系交代層構造強誘電体薄膜の作製と評価
(名大エコトピア研究) 坂本 渉, 今田 圭一, 志村 哲生, 余語 利信

- (26-T-17) All-Epitaxial Tri-Layered Ferroelectric
 $(\text{Bi,La})_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}/\text{Pb}(\text{Zr}_{0.4}\text{Ti}_{0.6})\text{O}_3/(\text{Bi,La})_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ Thin Films on SrTiO_3
 Substrates by Pulsed Laser Deposition
 (Sun Yat-Sen Univ. and *Max-Planck Inst) D. Bao, X. Zhu*, M. Alexe*, D. Hesse*

基礎(I)

(座長) 野口 祐二 (東京大学)

10:30--12:00

- (26-B-1) $(1-x)\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3-x\text{PbTiO}_3$ 単結晶における誘電率とドメイン構造の熱処理降温速度依存性
 (防衛大通信) 沖野 裕丈, 坂本 順一, 山本 孝
- (26-B-2) PZNのフィンガープリントパターンの電場依存性と誘電特性
 (名工大, *岐阜大, **愛知淑徳大) 岩田 真, 長谷川 祐介, 前田 雅輝, 安田 直彦*, 石橋 善弘**
- (26-B-3) TiNO_3 結晶のブリルアン散乱とドメイン観測
 (電通大量子物質, *杏林大医) 高木 康成, 河野 寛之, 竹内 義雄*
- (26-B-4) 走査型非線形誘電率顕微鏡を用いたナノスケール強誘電体ドメイン構造の3次元観測
 (東北大通研) 杉原 智之, 長 康雄
- (26-B-5) 混合系ペロブスカイト型化合物 $(1-x)\text{BiFeO}_3-x\text{BaTiO}_3$ の強誘電性と構造変化
 (大阪府大総合, *早大理工, **物材研) 堀部 陽一, 中山 真紀, 森 茂生, 浅田 敏広*, 小山 泰正*, 浅香 透**, 松井 良夫**
- (26-B-6) Ti置換した YMnO_3 の構造相転移と強誘電分域構造
 (大阪府大, *早稲田大理工学) 森 茂生, 徳永 純, 堀部 陽一, 相川祐一*, 勝藤 拓郎*

圧電材料(II)

(座長) 山本 孝 (防衛大学校)

13:15--14:45

- (26-P-6) PIMNT 24/42/34単結晶の誘電・圧電特性
 (東芝研究開発センタ, *早大理工) 細野 靖晴, 山下 洋八, 平山 健太郎*, 一ノ瀬 昇*
- (26-P-7) パルセラムックス $\text{Pb}(\text{Zr,Ti})\text{O}_3$ を用いたマイクロデバイスの作製
 (立命大) 田中 克彦, 小西 隆寛, 井出 雅人, 孟志葱, 杉山 進
- (26-P-8) スパッタおよびドライエッチング法により作製したPZT圧電用素子の特性評価
 (アルバック) 神保 武人, 木村 勲, 西岡 浩, 菊地 真, 小風 豊, 遠藤 光広, 植田 昌久, 鄒 紅コウ
- (26-P-9) 負性容量回路を利用したPZTセラミックスによる超音波域における弾性波遮断
 (井元製作所, *小林理学, **関西大工) 井元 健二, 西浦 充紘, 山本 健*, 伊達 宗宏*, 深田 栄一*, 田實 佳郎**
- (26-P-10) アルコキシド法 $\text{Ba}(\text{Ti,Zr})\text{O}_3$ 薄膜の微構造制御と誘電・圧電特性
 (*産総研, **名工大) 田中 清高*, **, 鈴木 一行*, 西澤 かおり*, 三木 健*, 加藤 一実*, **
- (26-P-11) Dielectric and Piezoelectric Properties of Low Temperature Sintering PMW-PNN-PZT Ceramics for Multilayer Piezoelectric Actuator.
 (Semyung Univ. and *KETI) K. Yoo, J. Yoo, H. Lee, K. Chung, S. Lee, H. Lee* and H. Kang*

薄膜(IV)

(座長) 藤村 紀文 (大阪府立大学)

15:00--15:45

- (26-T-18) ゾルゲル-水熱処理によるBaTiO₃薄膜の210 以下の低温作製
(大阪大基礎工学) 直山 卓示, 崎岡 洋司, 原田 圭一郎, 野田 実, 奥山 雅則
- (26-T-19) 非Pb系 リラクサー強誘電体(バルクと薄膜): Ba(Zr_xTi_{1-x})O₃, Ba(Hf_xTi_{1-x})O₃ (x=0-1)
の結晶構造 誘電物性
(阪大産研, *岡山大理) 土井 敦裕, 田畑 仁, 金 秀宰*, 黒岩 芳弘*
- (26-T-20) Factors Influencing the Tunability and the Microwave Properties of RF Magnetron Sputtered
(Ba,Sr)TiO₃ Thin Films grown on Al₂O₃ Ceramic Substrates
(Gennum Corp., *Tokyo Inst. of Tech., **ULVAC Inc.) I.P. Koutsaroff, A.
Cervin-Lawry, T. Bernacki, M. Zelner S. Ito*, H. Funakubo*, T. Jimbo** and K.

- 招待講演 (座長) 奥山 雅則 (大阪大学) 16:00--16:30**
- (26-I-1) Relaxor Ferroelectric Single Crystals for High Performance Piezoelectric Applications
(Penn State Univ.) T. Shrout
- 特別講演 (座長) 石橋 善弘 (愛知淑徳大学) 16:30--17:30**
- (26-S-1) 圧電トランスのこと(原料から分極まで)
(タム製作所顧問) 五十嵐 秀二

5月27日(金) パラレルセッション 202号室

- マイクロ波材料(I) (座長) 岸 弘志 (太陽誘電) 9:00--10:15**
- (27-M-1) 非接触プローブを用いた誘電体の高周波誘電率測定
(東京工大) 掛本 博文, 南 ソミン, 和田 智志, 鶴見 敬章
- (27-M-2) TiO₂/Al₂O₃積層型一次元フォトニック結晶の作製とTHz-TDS法による透過特性の評価
(村田製作所, *阪大接合研) 松本 直樹, 中川 卓二, 安藤 陽, 坂部 行雄, 桐原 聡秀*,
宮本 欽生*
- (27-M-3) Electrical and Structural Properties of Sputtered Y Doped BaSrTiO₃ Thin Films for GHz
Decoupling Applications
(Fujitsu, *Stanford Univ.) J.D. Baniecki, K. Nomura, T. Shioga, K. Kurihara, R. -V.
Wang*, P.C. McIntyre* and R. Zednik*
- (27-M-4) Influence of the Substrate Type Dependence on the Microwave Properties of the BST Thin
Films
(NAIST) G. Bhakdisongkhram, Y. Yamashita, T. Nishida and T. Shiosaki
- (27-M-5) The Comparison of Materials Property of Ferroelectric Thin Films Measured in Microwave
Frequency
(Nat'l Tsing Hua Univ., *Industrial Tech. Research Inst.) W. -A. Lan, W. -T. Huang*
and T. -B. Wu
- 強誘電体材料(II) (座長) 塩寄 忠 (奈良先端大) 10:30--12:00**
- (27-F-7) Bi₄Ti₃O₁₂単結晶の欠陥構造と分極特性
(*東大先端研, **科技機構さきかけ) 野口 祐二**, 松本 隆典*, 後藤 崇*, 宮山 勝*

- (27-F-8) Flux Growth of Pure and Lanthanum(La³⁺)Substituted Bi₄Ti₃O₁₂ Single Crystals and Their Characterization
(NIMS) C.V.Kannan, Z.X.Cheng, H.Kimura and A.Miyazaki
- (27-F-9) Ferroelectric Nanodomain Shapes in Near-Stoichiometric and Congruent LiNbO₃ Investigated by Scanning Force Microscopy
(NIMS) X. Liu, K. Terabe and K. Kitamura
- (27-F-10) Electrostrictive Properties of Pr doped BaTiO₃-CaTiO₃ Ceramics
(*PRESTO JST, **AIST) X. Wang*, H. Yamada*, K. Nishikubo** and C.-N. Xu**,**
- (27-F-11) Ferroelectric Studies on Sr_{0.61}Ba_{0.39}Nb₂O₆ Single Crystal Grown by Double Crucible Stepanov Technique
(NIMS) S. Ganesamoorthy, S. Kumaragurubaran, S. Takekawa, M. Nakamura, R. Mohankumar and K. Kitamura
- (27-F-12) A Study on the Dielectric and Pyroelectric Properties(Ba,Sr,Ca)TiO₃ Ceramics as a Function of Calcined Temperature
(Sun Moon Univ.) S.-H. Lee and S.-S. Lim

圧電材料(III)

(座長) 山下 洋八 (東芝)

13:15--14:45

- (27-P-12) スクリーン印刷法によるBaTiO₃厚膜の作製と評価
(村田製作所) 中磯 俊幸, 景山 恵介, 安藤 陽, 坂部 行雄
- (27-P-13) TMC法による{111}面板状BaTiO₃粒子の合成と配向セラミックスへの応用
(豊田中央研究所) 齋藤 康善, 高尾 尚史
- (27-P-14) BaTiO₃単結晶の圧電特性評価とアクチュエータの試作
(いわき明星大) 佐田 透, 横須賀 勝, 高重 正明
- (27-P-15) V置換SrBi₂Nb₂O₉セラミックスの圧電的性質
(東理大理工) 青柳 倫太郎, 稲井 慎也, 晝間 裕二, 竹中 正
- (27-P-16) SrBi₂Nb₂O₉配向セラミックスの圧電特性
(村田製作所) 小川 弘純, 澤田 拓也, 木村 雅彦, 白露 幸祐, 和田 信之, 安藤 陽, 田村 博, 坂部 行雄
- (27-P-17) NaNbO₃系圧電セラミックスの研究: (Bi_{1/2}M_{1/2})(Li_{1/4}Nb_{3/4})O₃ (M=K, Na and Li)の添加効果
(京セラ, 兵庫県立大*) 中井 泰広, 山川 健二, 百瀬 一久, 蒔崎 孝二, 山中 秀樹, 阿部 次郎*, 小舟 正文*

圧電材料(IV)

(座長) 竹中 正 (東京理科大学)

15:00--16:00

- (27-P-18) ラマン散乱分光による(Na_{0.5}K_{0.5})NbO₃-LiNbO₃系圧電セラミックスの構造評価
(名工大物質工) 柿本 健一, 赤尾 光一郎, 郭 益平, 大里 齋
- (27-P-19) 新圧電ほうろく酸塩結晶:LiRbB₆O₁₀の育成と評価
(山口大工) 上宇都 啓, 池田 攻, 小松 隆一
- (27-P-20) 点群mに属するLaCa_qO(BO₃)₃結晶の誘電・弾性・圧電諸定数
(奈良先端大) 清水 寛之, 武田 博明, 西田 貴司, 岡村 総一郎, 塩崎 忠

- (27-P-21) $K_2T_4O_9$ を用いた $K_{1/2}Bi_{1/2}TiO_3$ 針状粉体の合成
(日本大学) 内木場 文男, 渡辺 誠, 飯田 友治, 塚本 輝夫

マイクロ波材料(II) (座長) 田村 博 (村田製作所) 16:15--17:15

- (27-M-6) 粒子配向した層状ペロブスカイト化合物 $BaLa_4Ti_4O_{15}$ セラミックスのマイクロ波誘電特性
(名工大院物質工) 和田 賢介, 深見 裕子, 柿本 健一, 大里 齊
- (27-M-7) チューナブルマイクロ波用低温焼成ガラスセラミックスにおける $BaTiO_3$ 相への陽イオン置換
(北大工, 村田製作所*, 北見工大**) 高橋 順一, 清野 肇, 中野 浩志, 景山 恵介*, 伊藤 英信**
- (27-M-8) 球状酸化物誘電体粉末およびこれを用いた樹脂コンポジットの高周波誘電特性
(TDK基礎材料開発センタ) 車 声雷, 金田 功, 坂本 典正
- (27-M-9) シナイト型 $R(W_{0.5}Ti_{1.5})O_6$ (R=rare earth)セラミックスのマイクロ波誘電特性と結晶構造解析
(名城大, *名工大) 菅 章紀, 小川 宏隆, 大石 武志, 横井 敦史, 大里 齊*

5月27日(金) パラレルセッション 201号室

基礎(II) (座長) 上江洲 由晃 (早稲田大学) 9:00--10:15

- (27-B-7) EXAFS Study of Zn:Doped $LiNbO_3$ Crystals
(Nat'l Taiwan Normal Univ., *Nat'l Hsinchu Teacher College, **Soochow Univ., ***Nat'l Synchrotron Radiation Research Center) P.-J. Chang, C.-C. Lee, C.-T. Chia, C.-M. Lin, * K. T. Wu** and Jyh-Fu Lee***
- (27-B-8) 新規強誘電体 $BaTi_2O_5$ の単結晶・セラミックスの合成と物性
(島根大教育) 秋重 幸邦
- (27-B-9) $(Sr_{1-x}Ca_x)Bi_3Ti_2NbO_{12}$ ($x=0\sim 1$)セラミックスの強誘電特性と結晶構造
(名城大理工学) 小川 宏隆, 横井 敦史, 竹谷 秀一
- (27-B-10) リラクサー $Pb(In_{0.5}Nb_{0.5})O_3$ のPDF解析
(原研 放射光, *高輝度光科学研究センター) 米田 安宏, 水木 純一郎, 小原 真司*
- (27-B-11) PZT立方晶の放射光精密構造物性
(岡山大理, *筑波大数理物質, **名古屋大工, ***JASRI, ****CREST/JST) 黒岩 芳弘****, 寺戸 良博, 澤田 昭勝, 山村 泰久*, 青柳 忍**, 西堀 英治**, 坂田 誠**, 高田 昌樹***, *****

基礎(III) (座長) 岩田 真 (名古屋工業大学) 10:30--12:00

- (27-B-12) 第一原理計算による巨大電気分極の予測
(広大院先端, *科技振ERATO) 浦谷 佳孝, 獅子堂 達也, 石井 史之*, 小口 多美夫
- (27-B-13) FeRAMにおけるインプリントメカニズムの解析
(セイコーエプソン, *日本ファインセラミックスセンター, **広島大) 宮澤 弘, 濱田 泰彰, 樋口 天光, 名取 栄治, 木島 健, 下田 達也, 吉矢 真人*, 小口 多美夫**

- (27-B-14) 格子歪みにより誘起されたSrTiO₃の強誘電相の第一原理計算
(東北大金研, *NECトキン) 橋本 孝俊, 西松 毅, 水関 博志, 川添 良幸, 佐々木 淳*, 池田 義秋*
- (27-B-15) Field-Induced Effects in Brillouin Spectra in Lead Magnesium Niobate Crystals
(Ioffe Phys. Tech. Inst., *Hallym Univ., **筑波大物質工) S. Lushnikov, Jae Hyeon Ko*, 小島誠治**
- (27-B-16) La₃Ga₅GeO₁₄-Ba₃Ga₂Ge₄O₁₄系ガラスにおけるランガサイト相の結晶化およびRamanスペクトル
(NIMS ICYS, *NIMS, **長岡技科大) 高橋 儀宏, 北村 健二*, 井上 悟*, 紅野 安彦**, 藤原 巧**, 小松 高行**
- (27-B-17) 強誘電特性の粒径依存性に関する理論的考察
(太陽誘電) 相川 豊, 茶園 広一

基礎 高分子 液晶 (座長) 小島 誠治 (筑波大学) 13:15--14:45

- (27-E-1) ペロフスカイト型量子常誘電性酸化物における誘電応答の光・電場制御
(北大院理, *北大電子研, **東工大応セラ研, ***東工大院理工, **** ERATO JST) 武貞 正樹, 須藤 幸太, 小野 寺彰, 八木 駿郎*, 伊藤 満**, 腰原 伸也***, ****
- (27-E-2) 高温のSrTiO₃における見かけの巨大誘電緩和
(早大理工) 福永 守, 上江洲 由晃, 小林 航, 寺崎 一郎
- (27-E-3) 高分子安定化強誘電性液晶の分子運動に関する研究
(東理大基礎工) 古江 広和, 権田 瑞穂, 幡野 純
- (27-E-4) 強誘電性液晶自己保持膜における電界誘起振動分布の測定
(防衛大電気電子, *阪大院工) 森武 洋, 戸田 耕司, 尾崎 雅則*, 吉野 勝美*
- (27-E-5) 磁場を利用し作成した新規な無機/高分子複合膜の圧電性
(関西大工, *住友重機) 奥野 政樹, 守本 雄, 土本 吉宏, 金崎 雅義, 石塚 正之*, 田實 佳郎
- (27-E-6) 圧電性キラル高分子膜におけるポツケルス効果の測定
(ユニオプト, *関西大工) 築地 光雄, 高和 宏行, 村木 可苗, 田實 佳郎*

薄膜(V) (座長) 野田 実 (大阪大学) 15:00--16:00

- (27-T-21) Low Critical Current Density in BiFeO₃ Thin Films Fabricated by Chemical Solution Method
(Tokyo Inst. of Tech., *Sophia University) S. K. Singh, R. Ueno, H. Funakuba, H. Uchida*, S. Kado* and H. Ishiwara
- (27-T-22) Pt基板における熱的安定性の改善
(芝浦工大工, *八戸工大工) 山口 正樹, 山本 麻, 増田 陽一郎*
- (27-T-23) ペロフスカイトナノシーからのKNbO₃薄膜の作製
(新潟大) 戸田 健司, 菅原 晃, 上松 和義, 佐藤 峰夫
- (27-T-24) PLD法による高品質NaNbO₃薄膜の作製
(龍谷大理工, 松下先端研*) 齊藤 武尚, 安達 晴美, 和田 隆博, 足立 秀明*

薄膜(VI) (座長) 田畑 仁 (大阪大学) 16:15--17:15

- (27-T-25) Microstructure and Electrical Property Relationship in Ce, Cr, Er Doped Lead Zirconate Thin Films Prepared by Sol-gel Process
(*Kocaeli Univ., **NAIST and ***Gebze Inst. of Tech.) E. M. Alkoy*, **, S. Alkoy**, ***, T. Shiosaki**
- (27-T-26) ソルゲル法によるTi:LiNbO₃薄膜の作製とその物性評価
(中部大工, *山寿セラミックス) 芳賀 剛, 高橋 誠, 西脇 彰, 脇田 紘一, 八木 透*, 佐橋 家隆*
- (27-T-27) バルク光起電力性の積層膜構造体を用いた光センサの作製とその特性
(産総研, *東京電機大) 一木 正聡, 古江 治美, 小林 健, 森川 泰, 野中 一洋, 前田 龍太郎, 中田 毅
- (27-T-28) AD法による積層デバイス形成のための銅電極成膜
(産総研) 森 正和, 明渡 純

チュートリアル (座長) 塩崎 忠 (奈良先端大) 17:30--18:30

- (27-TU-1) 強誘電体薄膜の最近の展開
(大阪大学) 奥山 雅則

5月28日(土)

薄膜(VII) (座長) 中村 孝 (ローム) 9:00--10:15

- (28-T-29) MOCVD法による立方晶Bi_{1.5}Zn_{1.0}Nb_{1.5}O₇(BZN)エピタキシャル薄膜の作製とその電気特性
(東京工大, 上智大*) 岡浦 伸吾, 鈴木 宗泰, 岡本 庄司, 内田 寛*, 幸田 清一郎*, 舟窪 浩
- (28-T-30) YMnO₃/Y₂O₃/SiエピタキシャルMFISキャパシタの低温成長と層の薄膜化とその評価
(大阪府大院) 原武 耕平, 重光 学道, 西嶋 正憲, 吉村 武, 藤村 紀文
- (28-T-31) ECRスパッター法によるGe-MISキャパシタの形成と電気的特性
(諏訪東京理科大, *東京農工大, **NTTアフテイ) 福田 幸夫, 上野 智雄*, 廣野 滋**
- (28-T-32) 低ビット誤り率特性を有する超高密度強誘電体記録
(東北大通研) 平永良臣, 長 康雄
- (28-T-33) 強誘電強弾性Ta₂O₅単結晶薄膜の光学特性
(山梨大医学工学総合研究) 中川 恭彦, 高橋 真志, 森田 功, 垣尾 省司

圧電応用 (座長) 安達 正利 (富山県立大学) 10:30--11:30

- (28-A-1) 圧電トランス表面電位の絶対値と放電電力の空間分布
(千葉工大) 寺西 研二, 鈴木 進, 伊藤 晴雄
- (28-A-2) AD法で形成したPZT厚膜駆動による板波共鳴型高速マイクロ光スキャナー
(産総研) 明渡 純, M. Lebedev, 佐藤 治道, J. Park
- (28-A-3) PZT圧電アクチュエータ駆動光スキャナの作製
(産総研) 小林 健, J. Tsaur, 前田 龍太郎

(28-A-4)

Growth and Application in Transducers of Relaxor Ferroelectric PMN-PT Single Crystals

(Chinese Academy of Sci.) C. Feng, G. Xu